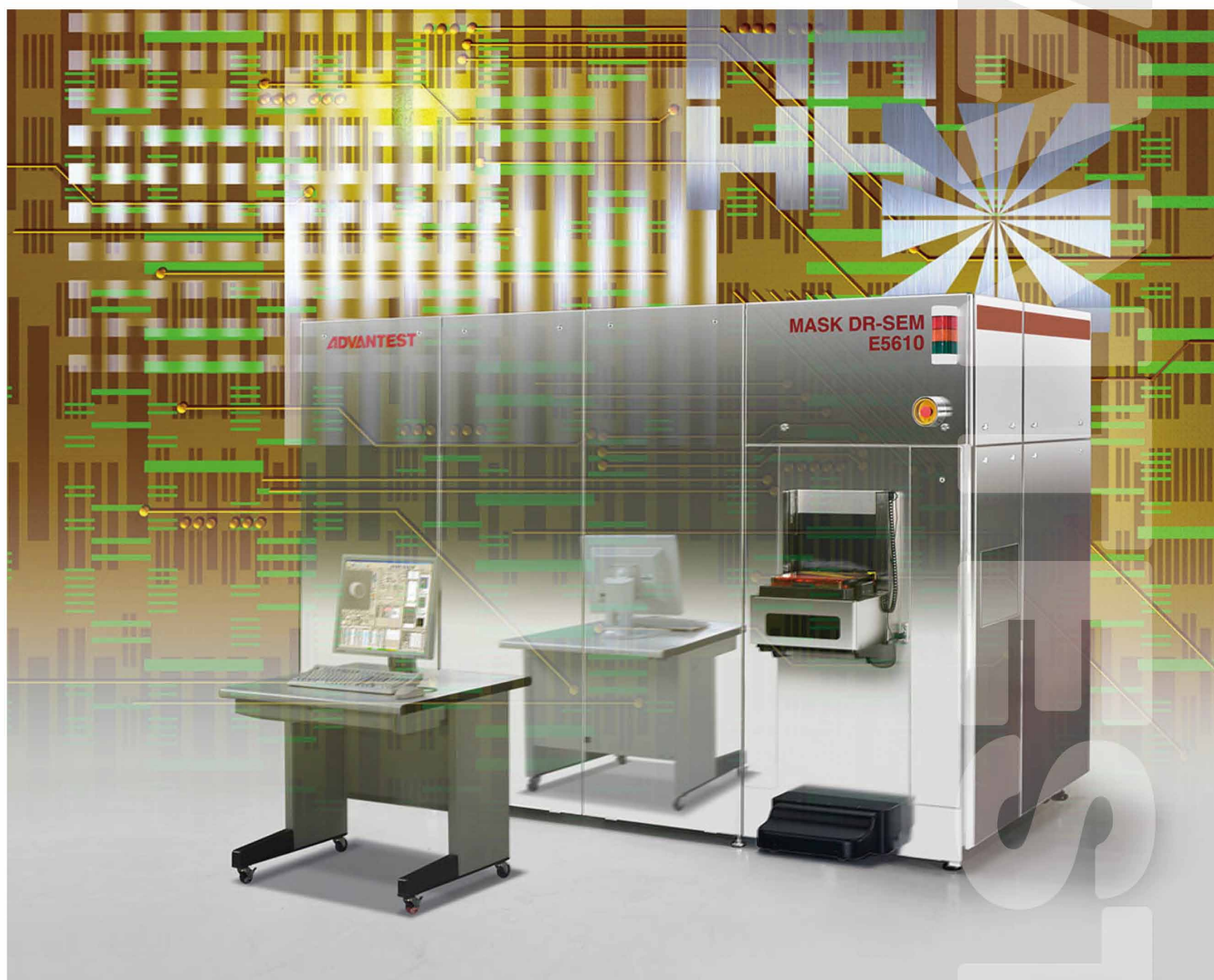


ADVANTEST[®]

MASK DR-SEM

E5610

フォトマスク対応の欠陥レビューSEM



E5610は、フォトマスク上の微小欠陥のレビューとクラシフィケーションを可能にする、MASK DR-SEM¹⁾です。

フォトマスク用MVM-SEM[®]で定評のある当社独自の高いチャージ抑制技術とステージ精度により、高安定・全自動画像取得が可能となり、欠陥検査装置より出力される座標データから簡単に欠陥をイメージングする事ができます。

さらにオプションで、ビームチルト技術による傾斜観察機能とEDS²⁾による元素分析機能も搭載可能です。

E5610は、高精度、高スループットの欠陥レビュー性能により、最先端フォトマスクの品質向上とTAT短縮に貢献します。

1) Defect Review - Scanning Electron Microscope (欠陥レビュー用走査型電子顕微鏡)

2) Energy Dispersive X-ray Spectrometry (エネルギー分散型X線分析)

高い空間分解能

当社独自のカラム・アーキテクチャにより、フォトマスクの観察に適した低加速電圧でも、2nmという高い空間分解能を実現しました。

高安定・全自動画像取得

高精度ステージ、チャージアップ抑制技術、コンタミネーション低減技術により、高いSEM倍率においても自動、かつ安定的に欠陥画像を高スループットで取得できます。

欠陥検査装置との連携

欠陥検査装置から出力される欠陥位置情報を読み込み、該当位置の欠陥画像を自動収集します。

傾斜観察機能

最大15°までビームを傾斜させることができるユニークなチルト・モジュールが搭載可能です。電氣的制御による傾斜観察により、パターン側壁などのレビューを可能にしました。

元素分析機能

最新のEDSモジュールが搭載可能です。観察部位から放出される特性X線のスペクトラムを分析し、構成元素を特定します。

MVM-SEMは、(株)アドバンテストの日本、米国およびその他の国における登録商標または商標です。



一般仕様

搬送可能試料:	6025サイズのフォトマスク
SEM空間分解能:	2nm
ビームチルト角*:	最大15°
ステージ位置決め精度:	±75nm
加速電圧:	0.3kV~10kV
プローブ電流:	1pA~1nA
EDSエネルギー分解能*:	138eV

*オプション

※チルト・モジュールとEDSモジュールの組合せについては別途ご相談下さい。

- 本製品を正しくご利用いただくため、お使いになる前に必ず取扱説明書をお読み下さい。
- 本カタログ記載の製品仕様及び外観等は、予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

ADVANTEST®

<http://www.advantest.co.jp>

株式会社 **アドバンテスト**

●本製品に関するお問合せは
ナノテクノロジー事業部
〒349-1158 埼玉県加須市新利根1-5 埼玉R&Dセンタ
TEL : 0480-72-6300
E-mail : info_nano@ml.advantest.com